



(11)

EP 3 404 730 B8

(12)

## FASCICULE DE BREVET EUROPEEN CORRIGÉ

(15) Information de correction:

**Version corrigée no 1 (W1 B1)**  
**Corrections, voir**  
**Bibliographie code(s) INID 73**

(51) Int Cl.:

**H01L 45/00 (2006.01)****H01L 27/24 (2006.01)**

(48) Corrigendum publié le:

**18.12.2019 Bulletin 2019/51**

(45) Date de publication et mention de la délivrance du brevet:

**23.10.2019 Bulletin 2019/43**(21) Numéro de dépôt: **18170884.3**(22) Date de dépôt: **04.05.2018****(54) MEMOIRE NON VOLATILE FAVORISANT UNE GRANDE DENSITE D'INTEGRATION**

NICHT-FLÜCHTIGER SPEICHER, DER EINE GROSSE INTEGRATIONSDICHTE BEGÜNSTIGT  
 NON-VOLATILE MEMORY PROMOTING HIGH INTEGRATION DENSITY

(84) Etats contractants désignés:

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB  
 GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO  
 PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorité: **12.05.2017 FR 1754181**

(43) Date de publication de la demande:

**21.11.2018 Bulletin 2018/47**

(73) Titulaires:

- **COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES**  
**75015 Paris (FR)**
- **Université d'Aix Marseille**  
**13007 Marseille 7 (FR)**
- **Centre National de la Recherche Scientifique**  
**75016, Paris 16 (FR)**

(72) Inventeurs:

- **PORTAL, Jean-Michel**  
**13119 SAINT-SAVOURNIN (FR)**

- **BARLAS, Marios**  
**38400 ST MARTIN D'HÈRES (FR)**
- **GRENOUILLET, Laurent**  
**38640 CLAIX (FR)**
- **VIANELLO, Elisa**  
**38000 GRENOBLE (FR)**

(74) Mandataire: **GIE Innovation Competence Group**  
**310, avenue Berthelot**  
**69372 Lyon Cedex 08 (FR)**

(56) Documents cités:

<b>EP-A1- 2 178 122</b>	<b>CN-A- 102 738 390</b>
<b>US-A1- 2012 012 944</b>	<b>US-A1- 2013 221 317</b>
<b>US-B1- 8 598 560</b>	

- **CHIN YU MEI ET AL: "28nm high-k metal gate RRAM with fully compatible CMOS logic processes", VLSI TECHNOLOGY, SYSTEMS, AND APPLICATIONS (VLSI-TSA), 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON, IEEE, 22 avril 2013 (2013-04-22), pages 1-2, XP032431005, DOI: 10.1109/VLSI-TSA.2013.6545590 ISBN: 978-1-4673-3081-7**

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).